

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 10 月 9 日 (09.10.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/083002 A1

(51) 国際特許分類⁷: C09J 7/02, H01L 21/68, 21/304

(21) 国際出願番号: PCT/JP03/03705

(22) 国際出願日: 2003 年 3 月 26 日 (26.03.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-090493 2002 年 3 月 28 日 (28.03.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒100-6070 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 才本 芳久 (SAIMOTO, Yoshihisa) [JP/JP]; 〒457-8522 愛知県名古屋市南区丹後通2-1 三井化学株式会社内 Aichi

(JP). 片岡 真 (KATAOKA, Makoto) [JP/JP]; 〒457-8522 愛知県名古屋市南区丹後通2-1 三井化学株式会社内 Aichi (JP). 宮川 誠史 (MIYAKAWA, Masafumi) [JP/JP]; 〒457-8522 愛知県名古屋市南区丹後通2-1 三井化学株式会社内 Aichi (JP). 早川 慎一 (HAYAKAWA, Shinichi) [JP/JP]; 〒457-8522 愛知県名古屋市南区丹後通2-1 三井化学株式会社内 Aichi (JP). 五十嵐 康二 (IGARASHI, Kouji) [JP/JP]; 〒457-8522 愛知県名古屋市南区丹後通2-1 三井化学株式会社内 Aichi (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, SG, US.

規則4.17に規定する申立て:

— USのための発明者である旨の申立て (規則4.17(iv))

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE FILM FOR PROTECTION OF SEMICONDUCTOR WAFER SURFACE AND METHOD OF PROTECTING SEMICONDUCTOR WAFER WITH THE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE FILM

(54) 発明の名称: 半導体ウエハ表面保護用粘着フィルム及び該粘着フィルムを用いる半導体ウエハの保護方法

(57) Abstract: A pressure sensitive adhesive film for protection of semiconductor wafer surface, comprising a base film of at least 200 ° C melting point and 10 to 200 μ m thickness having its front and back sides coated with pressure sensitive adhesive layers whose storage elastic modulus at 150 ° C is at least 1×10^5 Pa and whose thickness is in the range of 3 to 100 μ m. This pressure sensitive adhesive film enables preventing the breakage, contamination, etc. of semiconductor wafer in the process of grinding of semiconductor wafer back side and removing of any crushed layer generated on the back side even when the wafer layer thickness is reduced to 100 μ m or less.

(57) 要約: 融点が少なくとも200°C、厚みが10~200 μ mである基材フィルムの表裏両面に150°Cにおける貯蔵弾性率が少なくとも 1×10^5 Pa、厚みが3~100 μ mである粘着剤層が形成された半導体ウエハ表面保護用粘着フィルムであって、本発明によれば、半導体ウエハの裏面研削、及び裏面に生じた破碎層を除去する処理する工程において、厚さが100 μ m以下まで薄層化された場合であっても、半導体ウエハの破損、及び汚染等を防止することができる。



WO 03/083002 A1